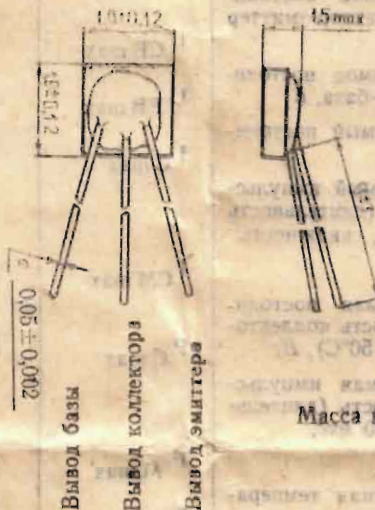


ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ

2Т679А-2, 2Т679Б-2

ЭТИКЕТКА

Кремниевые бескорпусные эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы типов 2Т679А-2, 2Т679Б-2, предназначенные для применения в импульсных и переключающих схемах и схемах усиления сигналов высокой частоты средней мощности.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПРИ $t_{amb} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$.

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		2Т679А-2		2Т679Б-2	
		не менее	не более	не менее	не более
Граничное напряжение ($I_E = 10 \text{ mA}$), В	$U_{(L) CEO}$	40	—	25	—
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер ($I_C = 500 \text{ mA}$, $I_B = 50 \text{ mA}$), В	$U_{CE sat}$	—	0,8	—	0,8
Обратный ток коллектора ($U_{CB} = 50 \text{ В}$ для 2Т679А-2), мкА	I_{CBO}	—	1,0	—	1,0
($U_{CB} = 25 \text{ В}$ для 2Т679Б-2), мкА	I_{CBO}	—	—	—	1,0
Обратный ток эмиттера ($U_{EB} = 3 \text{ В}$), мкА	I_{EBO}	—	50	—	50
Статический коэффициент передачи тока ($U_{CB} = 2 \text{ В}$, $I_E = 500 \text{ mA}$)	h_{21E}	20	80	20	80

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра, режим и условия измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Примечание
		2Т679А-2	2Т679В-2	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{CB\ max}$	50	25	1
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер ($R_{BE} = 1\ \text{кОм}$), В	$U_{CE\ max}$	50	25	1
Максимальное допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{EB\ max}$	3	3	1
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{C\ max}$	0,5	0,5	2
Максимально допустимый импульсный ток коллектора (длительность импульса $\tau_u \leq 100\ \text{мкс}$, скважность $Q \geq 2$, $t_{case} = -25^\circ\text{C}$), А	$I_{CM\ max}$	1	1	2
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора ($t_{case} = \text{минус } 60 \div 50^\circ\text{C}$), Вт	$P_{C\ max}$	1	1	3
Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность (длительность импульса $\tau_u \leq 100\ \text{мкс}$, скважность $Q \geq 2$), Вт	$P_{M\ max}$	1,5	1,5	3
Максимально допустимая температура перехода $^\circ\text{C}$	$t_{j\ max}$	150	150	

- ПРИМЕЧАНИЯ:**
1. При $t_{слэв} = (\text{минус } 60 + 125)^\circ\text{C}$.
 2. При $t_{слэв} = (\text{минус } 60 + 125)^\circ\text{C}$ при условии непревышения максимально рассеиваемой мощности для данной температуры.
 3. В диапазоне температур t_{case} от $+50^\circ\text{C}$ до $+125^\circ\text{C}$

$P_{C\ max}$ и $P_{M\ max}$ рассчитываются по формуле:

$$P_{C\ max} = \frac{150 - t_{case}}{R_{thjc}}$$

где R_{thjc} — тепловое сопротивление переход-корпус микросхемы, равное: $100^\circ\text{C}/\text{Вт}$ для статического режима; $67^\circ\text{C}/\text{Вт}$ для импульсного режима.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ:
золота 1,978 мг в том числе: 0,0000379 г/мм на 3 выводах длиной (11 ± 1) мм.

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ В ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов 2Т679А-2, 2Т679В-2, соответствующий техническим условиям А0.339.620 ТУ и специальному дополнению А0.839.620 ТУ/ДЗ, РМ11-091-926-81.

Приняты по извещению № 3.1818

от 64 / Д дата